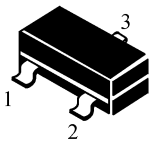
桂林斯壯微電子有限責任公司
Guilin Strong Micro-Electronics Co.,Ltd.

GM3356

SOT—23

1. BASE
2. EMITTER
3. COLLECTOR



■MAXIMUM RATINGS 最大額定值

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Rating 額定值	Unit 單位
Collector-Emitter Voltage 集電極發射極電壓	V_{CEO}	12	Vdc
Collector-Base Voltage 集電極基極電壓	V_{CBO}	20	Vdc
Emitter-Base Voltage 發射極基極電壓	V_{EBO}	3.0	Vdc
Collector Current-Continuous 集電極電流-連續	Ic	100	mAdc

■THERMAL CHARACTERISTICS 熱特性

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Max 最大值	Unit 單位
Total Device Dissipation 總耗散功率 FR-5 Board(1) T_A=25℃環境溫度爲 25℃ Derate above25℃ 超過 25℃遞減	P_D	225 1.8	mW mW/℃
Total Device Dissipation 總耗散功率 Alumina Substrate 氧化鋁襯底,(2)T_A=25℃ Derate above25℃超過 25℃遞減	P_D	300 2.4	mW mW/℃
Thermal Resistance Junction to Ambient 熱阻	$R_{\Theta JA}$	417	℃/W
Junction and Storage Temperature 結溫和儲存溫度	T_J,T_{stg}	-55to+150℃	

■DEVICE MARKING 打標

GM3356(2SC3356)=R25
HFE:50-100; 80-150; 120-220; 200-300

■ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

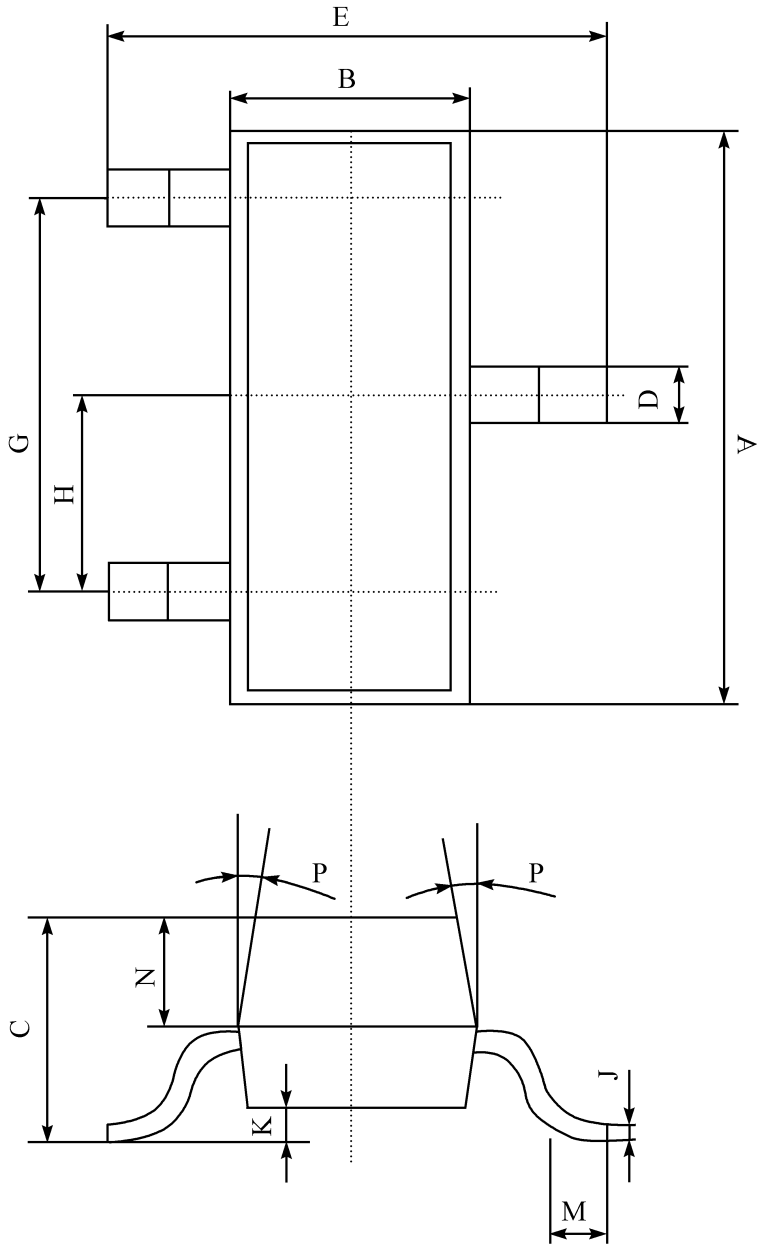
(T_A=25℃ unless otherwise noted 如無特殊說明，溫度爲 25℃**)**

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Min 最小值	Typ 典型值	Max 最大值	Unit 單位
Emitter Cutoff Current 發射極截止電流(V_{EB}=1.0v,I_C=0)	I_{EBO}	—	—	1.0	μA
Collector Cutoff Current 集電極截止電流(V_{CB}=10v,I_E=0)	I_{CBO}	—	—	1.0	μA
Collector-Base Breakdown Voltage 集電極基極擊穿電壓(Ic=10uA)	$V_{(BR)CBO}$	20	—	—	V
Collector-Emitter Breakdown Voltage 集電極發射極擊穿電壓(Ic=1mA)	$V_{(BR)CEO}$	12	—	—	V
Emitter-Base Breakdown Voltage 發射極基極擊穿電壓(I_E=10uA)	$V_{(BR)EBO}$	3	—	—	V
DC Current Gain 直流電流增益 (V_{CE}=10v,I_C=20mA)	H_{FE}	50	—	300	
Gain Bandwidth Product 增益帶寬乘積(V_{CE}=10v,I_C=20mA)	f_T	—	7000	—	MHz
Noise Figure 噪声係數 (V_{CE}=10V,Ic=7mA,f=1.0GHz)	NF	—	—	2.0	dB
Feed-Back Capacitance 反馈電容 (V_{CB}=10v,I_E=0,f=1.0MHz)	C_{re}	—	0.55	1.0	pF

1. FR-5=1.0×0.75×0.062in.
2. Alumina=0.4×0.3×0.024in.99.5%alumina.

GM3356

■DIMENSION 外形封裝尺寸



序號	數值及公差
A	2.90±0.10
B	1.30±0.10
C	1.00±0.10
D	0.40±0.10
E	2.40±0.20
G	1.90±0.10
H	0.95±0.05
J	0.13±0.05
K	0.00-0.10
M	≥0.2
N	0.60±0.10
P	7±2°